

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: a 2017 0049		
(22) Data depozit: 2017.04.20		
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD		
(54) Titlul: Procedeu de obținere a monocristalelor de arseniură de niobiu și tantal		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) Int.Cl: C30B 25/00 (2006.01) C01G 28/00 (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): Nateprov, Gherman, ARUSANOV, monocristal, cristal AND procedeu, arsen, As, tantal, Ta, niobiu, Nb,		
"Worldwide" (Espacenet): IC:C30B29/30 AND EN_CL:single IC:C30B* AND EN_CL:monocristal*, IC:C30B* AND EN_DE:tantal AND EN_DE:arseni* AND EN_CL:single, IC:C30B* AND EN_AB:resistance AND EN_CL:temperat* AND EN_AB:furnace AND EN_CL:single, EN_CL:growth AND EN_CL:TaAs, EN_CL:crystal AND EN_CL:TaAs, EN_CL:NbAs		
SU, EA, CIS (Eapatis): (C30B*IC) AND (арсенид*\AB), (C30B*IC) AND (ниоби*\AB), (C30B*IC) AND (тантал*\AB), (Способ\AB) AND (монокристалл*\AB), (темпер*\AB) AND (разн*\AB) AND (Способ\AB) AND (монокристалл*\AB), (градиент*\AB) AND (Способ\AB) AND (монокристалл*\AB), (выращиван*\AB) AND (градиент*\AB) AND (Способ\AB) AND (монокристалл*\AB), (Натепров\NM)		
Alte BD – tantalum arsenide TaAs single crystal, tantalum arsenide TaAs crystal growth, NbAs TaAs crystal growth, NbAs TaAs nateprov, nateprov gherman arusanov		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
www.google.ru		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	B. Q. Lv, H. M. Weng, B. B. Fu, X. P. Wang, H. Miao, J. Ma, P. Richard, X. C. Huang, L. X. Zhao, G. F. Chen, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, and H. Ding, Experimental	1-2

	Discovery of Weyl Semimetal TaAs, Phys.Rev.X5, 031013 (2015)	
A, D	T. Besara, D. Rhodes, K.-W. Chen, Q. Zhang, B. Zheng, Y. Xin, L. Balicas, R. E. Baumbach, and T. Siegrist, Non-stoichiometry and Defects in the Weyl Semimetals TaAs, TaP, NbP, and NbAs, arXiv:1511.03221v1 [cond-mat.mtrl-sci] 10 Nov 2015	1-2
A, D	Chandra Shekhar, Vicky Su and Marcus Schmidt, Mobility induced unsaturated high linear magnetoresistance in transition-metal monpnictides Weyl semimetals, arXiv:1606.06649v1[cond-mat.mtrl-sci] 21 June 2016	1-2
A, D, C	Zhilin Li, Hongxiang Chen, Shifeng Jin, Di Gan, Wenjun Wang, Liwei Guo, and Xiaolong Chen, Weyl Semimetal TaAs: Crystal Growth, Morphology, and Thermodynamics, Cryst. Growth Des. 16 (3), pp 1172-1175 (2016)	1-2
A	RU 2296189 C2 2007.03.27	1-2
A	G. S. Sxini, ". D. Calvert, AND J. B. Tayl. Preparation and characterization of crystals of Mx- and mx2-type awsenides of niobium and tantalum. Division of Applied Chemistry, National Research Council, Ottawa, Canada, Received October 19, 1963	1-2

*** categoriile speciale ale documentelor citate:**

A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri

Data finalizării documentării 2017.12.14

Examinator GHIȚU Irina jr.